

FGS15N40L

General Description

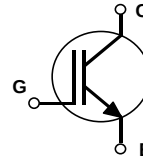
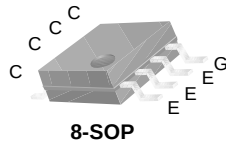
Insulated Gate Bipolar Transistors(IGBTs) with trench gate structure have superior performance in conductance and switching to planar gate structure and also have wide noise immunity. These devices are well suitable for strobe application

Features

- High Input Impedance
- High Peak Current Capability (130A)
- Easy Gate Drive

Application

- Strobe Flash



Absolute Maximum Ratings

$T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Description	FGS15N40L	Units
V_{CES}	Collector-Emitter Voltage	400	V
V_{GES}	Gate-Emitter Voltage	± 6	V
$I_{CM(1)}$	Pulsed Collector Current	130	A
P_C	Maximum Power Dissipation @ $T_a = 25^\circ\text{C}$	2.0	W
T_J	Operating Junction Temperature	-40 to +150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature Range	-40 to +150	$^\circ\text{C}$
T_L	Maximum Lead Temp. for soldering PurPoses from case for 5 secnds	300	$^\circ\text{C}$

Notes :

(1) Repetitive rating : Pulse width limited by max. junction temperature

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient(PCB Mount)	--	62.5	$^\circ\text{C/W}$

Notes: Mounted on 1" square PCB(FR4 or G-10 Material)

Electrical Characteristics of IGBT $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Off Characteristics						
BV_{CES}	Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{GE} = 0V, I_C = 1mA$	450	--	--	V
I_{CES}	Collector Cut-off Current	$V_{CE} = V_{CES}, V_{GE} = 0V$	--	--	10	μA
I_{GES}	G-E leakage Current	$V_{GE} = V_{GES}, V_{CE} = 0V$	--	--	± 0.1	μA
On Characteristics						
$V_{GE(th)}$	G-E threshold Voltage	$I_C = 0V, I_C = 1mA$	-	-	1.4	V
$V_{CE(sat)}$	C-E Saturation Voltage	$I_C = 130A, V_{GE} = 4.0V$	2.0	4.5	8.0	V
Dynamic Characteristics						
C_{ies}	Input Capacitance	$V_{GE} = 0V, V_{CE} = 30V$ $f = 1MHz$	--	3800	--	pF
C_{oes}	Output Capacitance		--	45	--	pF
C_{res}	Reverse Transfer Capacitance		--	30	--	pF
Switching Characteristics						
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	$V_{CC} = 300V, I_C = 130A$ $V_{GE} = 4.0V, R_G = 15\Omega$ * Resistive Load	--	0.15	--	us
t_r	Rise Time		--	1.5	--	us
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time		--	0.15	0.3	us
t_f	Fall Time		--	1.5	3.0	us

Notes : Recommendation of R_G Value : $R_G \geq 15\Omega$

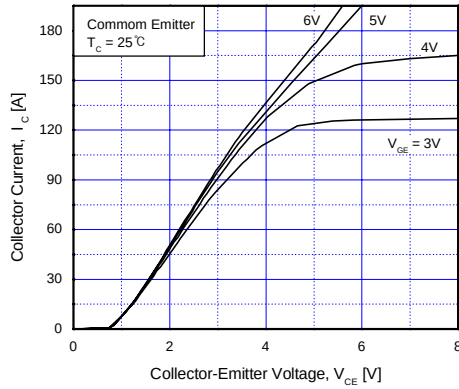


Fig 1. Typical Output Characteristics

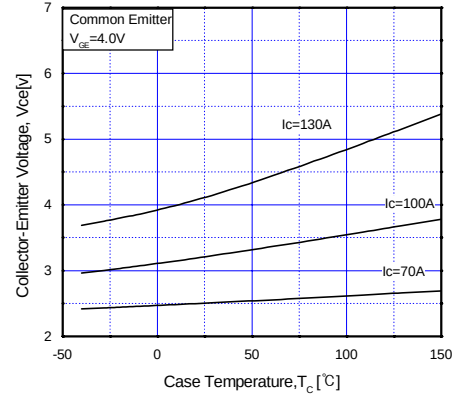


Fig 2. Saturation Voltage vs. Case Temperature at Variant Current Level

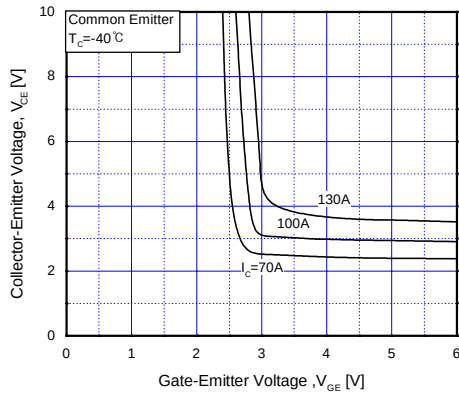


Fig 3. Saturation Voltage vs. V_{GE}

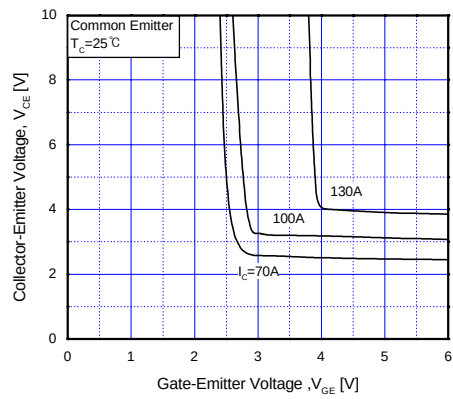


Fig 4. Saturation Voltage vs. V_{GE}

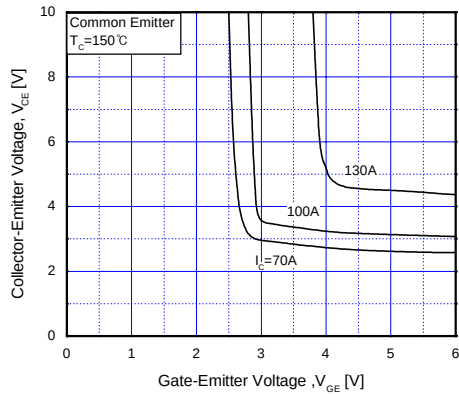


Fig 5. Saturation Voltage vs. V_{GE}

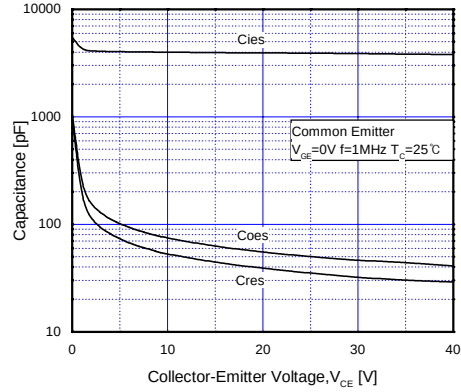


Fig 6. Capacitance Characteristics

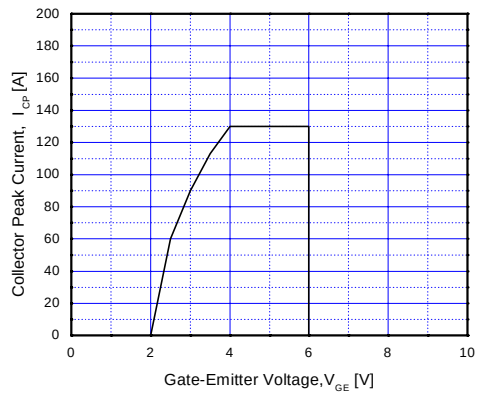
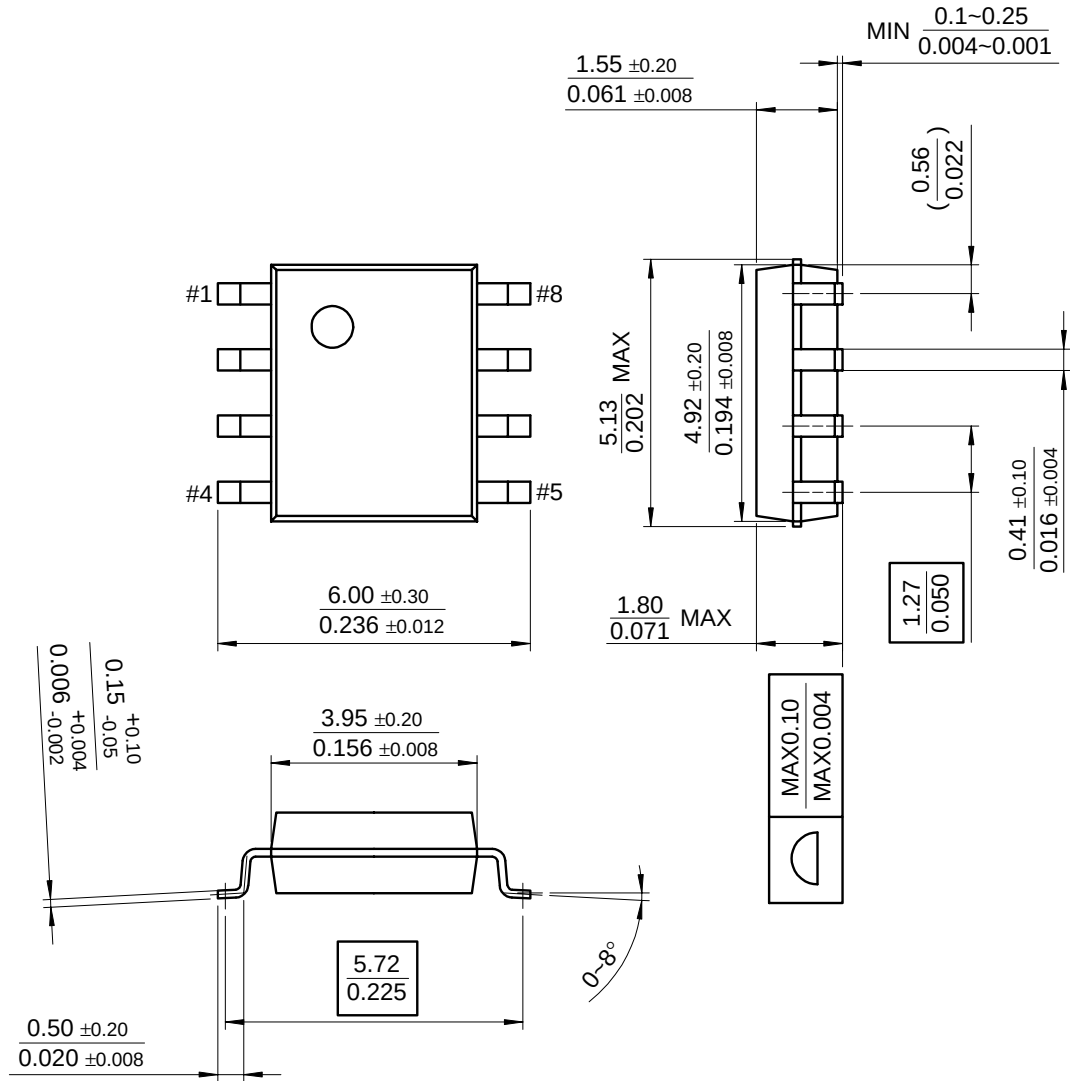


Fig 7. Collector Current Limit Vs Gate - Emitter Voltage Limit

Package Dimension

8-SOP



Dimensions in Millimeters

TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACE _x [™]	FAST [®]	OPTOLOGIC [™]	SMART START [™]	VCX [™]
Bottomless [™]	FAST _r [™]	OPTOPLANAR [™]	STAR*POWER [™]	
CoolFET [™]	FRFET [™]	PACMAN [™]	Stealth [™]	
CROSSVOLT [™]	GlobalOptoisolator [™]	POP [™]	SuperSOT [™] -3	
DenseTrench [™]	GTO [™]	Power247 [™]	SuperSOT [™] -6	
DOME [™]	HiSeC [™]	PowerTrench [®]	SuperSOT [™] -8	
EcoSPARK [™]	ISOPLANAR [™]	QFET [™]	SyncFET [™]	
E ² C MOS [™]	LittleFET [™]	QS [™]	TruTranslation [™]	
EnSigna [™]	MicroFET [™]	QT Optoelectronics [™]	TinyLogic [™]	
FACT [™]	MicroPak [™]	Quiet Series [™]	UHC [™]	
FACT Quiet Series [™]	MICROWIRE [™]	SLIENT SWITCHER [®]	UltraFET [®]	

STAR*POWER is used under license

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTERNATIONAL.

As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А